

114843

# 半 导 体 学 报

第 1 卷 第 3 期 1980 年 8 月

## 目 录

硅中杂质能级的理论计算.....陆 栋 陆 奋 (173)

非晶态硅薄膜的制备及其肖特基势垒的研究.....陈坤基 何宇亮 杜家方 (179)

Ge 对非晶硫系化合物半导体低温跳跃电导的影响 .....  
.....陈光华 王印月 吴锦华 甘润今 张仿清 (187)

铟离子注入的硫化锌的退火研究 ..... 虞家琪 F. J. Bryant (192)

椭圆偏光法研究砷离子注入硅的损伤和退火.....  
.....莫 党 卢因诚 李旦晖 刘尚合 卢武星 (198)

Gunn 器件中掺杂梯度引起的静止畴的计算机模拟 .....  
.....王守武 潘国雄 王重云 (204)

平面扩散砷化镓变容管.....田 牧 (220)

直接从 MOS 结构  $C-v$  曲线计算少数载流子体产生寿命的新方法 .....  
.....程文超 黄振岗 (228)

四毫米 GaAs 肖特基势垒二极管及混频器 ..... 混频器研制组 (234)

## 研 究 简 报

一种新的金属膜干法刻蚀技术.....韩阶平 吕秀英 杨占坤 胥兴才 (247)

离子注入无显影刻蚀技术.....王培大 韩阶平 裴荣祥 洪啸吟 (249)

激光退火对硅氧化层错的抑制作用.....鲍希茂 嵇福权 黄信凡 陈南斗 (251)

光电压光谱法测定磷砷化镓外延层的组成(二).....邱德仁 汪乃兴 (254)